



УДК 537.311

ВЛИЯНИЕ МОМЕНТОВ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОННО-ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ПРИМЕСИ

С.В. Гранько, А.В. Короткевич

УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»,
г.Минск, Беларусь

Аннотация: Предложена модель для расчета объемного распределения концентрации примеси внедренной в твердое тело методом ионной имплантации с использованием маскирующих покрытий. Математической основой модели является использование распределения Пирсона VII, описывающее распределение концентрации при использовании модели точечного пучка ионов. Установлены особенности влияния момента эксцесса на пространственное распределения примеси.

Ключевые слова: ионная имплантация, локальное ионное легирование, распределение Пирсона, асимметрия, эксцесс.

Представляемые в работах [1,2,3] методы построения пространственного распределения концентрации примеси введенной методом ионной имплантации через окно маскирующем покрытии сводятся к использованию описания бокового отклонения, которое претерпевают падающие ионы от направления перпендикулярного поверхности образца с помощью параметра $\Delta R_{p,l} / R_{p,l}$ – стандартное отклонение боковых пробегов ионов. При этом предполагается, что боковое распределение концентрации имплантированной примеси, или зависимость локальной концентрации от боковой координаты, является гауссовским с боковым проецированным пробегом $R_{p,l} / R_{p,l} = 0$. Однако при этом пренебрегается моментами более высоких порядков.

Однако при формировании ряда структур методом локального ионного легирования с использованием окон в маскирующем покрытии требуется учет моментов более высокого порядка. При этом пространственное распределение концентрации имплантированной примеси следующее:

$$n(x, y, z) = KDF_1^P(x) \iint_S F_2^P(Y - y) F_3^P(Z - z) dZdY, \quad (1)$$

где D доза ионной имплантации;

F_1^P – продольное распределение (по координате x), как правило описывается распределением Пирсона IV;

F_2^P, F_3^P – поперечное распределение по координатам y и z ;

S – параметр, характеризующий окно в маскирующем покрытии, имеет размерность площади, определяется координатами Y и Z .

K – нормировочный коэффициент.

Для описания бокового ухода предполагаем, что распределения по продольной координате (функции F_2^P или F_3^P) носят симметричный характер, параметр асимметрии $\gamma=0$ и может быть описано с помощью распределений Пирсона для различных значений эксцесс β . Аналитические выражения этих функций: определяется следующим образом (на примере координаты y):



вводятся следующие переменные зависящие, от моментов распределений

$$b_0 = \frac{\Delta R_p^2 (4\beta - 3\gamma^2)}{10\beta - 12\gamma^2 - 18}, \quad (2)$$

$$b_2 = \frac{2\beta - 3\gamma^2 - 6}{10\beta - 12\gamma^2 - 18}, \quad (3)$$

Распределение Пирсона VII для $\gamma=0$ и $\beta>3$

$$F^P(y) = \left| y^2 + \frac{b_0}{b_2} \right|^{\frac{1}{2b_2}}, \quad (6)$$

Для $\gamma=0$ и $\beta=3$ имеем распределение Пирсона VIII, которое идентично распределению Гаусса.

На рис.1 представлены нормированные относительно максимума распределения Пирсона VII и Пирсона VIII построенные с применением (2-6) для значений асимметрии $\gamma=0$ и эксцесса $\beta_1=3, \beta_2=5, \beta_3=10$. Данные профили распределения относительной концентрации имплантированной примеси могут быть применены в представлении модели точечного пучка ионов попадающего в точку поверхности мишени с координатой $y=0$ мкм (нм, ангстрем).

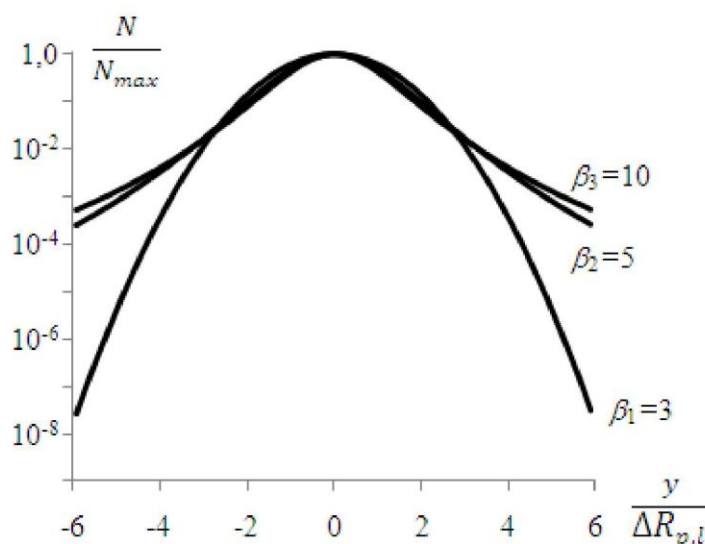
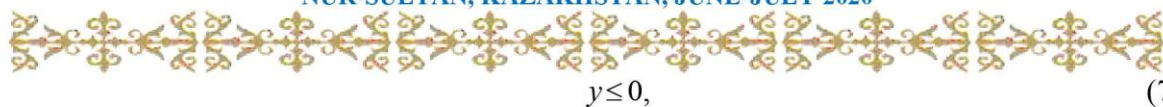


Рис. 1. Модельные профили поперечного распределения концентрации примеси для точечных пучков

Для расчета пространственного распределения концентрации примеси требуется интегрирование данных распределений по площади окна в маскирующем покрытии. В данной работе проведено моделирование пространственного распределения концентрации примеси маскирующей структурой локального ионного легирования является полуплоскость:



$y \leq 0,$ (7)

На рис. 2. представлены результаты численного интегрирования (1) модельных профилей для полуплоскости. Значения концентрации нормированы относительно максимума, наблюдается уход примеси под маску. На границе раздела «окно-маска» значение концентрации $0,5N_{max}$, что объясняется значением асимметрии $\gamma=0$, боковой уход ионов по обе стороны границы раздела равновероятен. На расстоянии $5\Delta R_{p,l}, \Delta R_{p,l}$ от границы раздела «окно-маска» концентрация примеси сформированной модельным профилем $\beta_2=5$ в 10^3 выше сформированной модельным профилем $\beta_1=3$. Концентрация примеси сформированной модельным профилем $\beta_2=5$ отличается от сформированной модельным профилем $\beta_3=10$ незначительно.

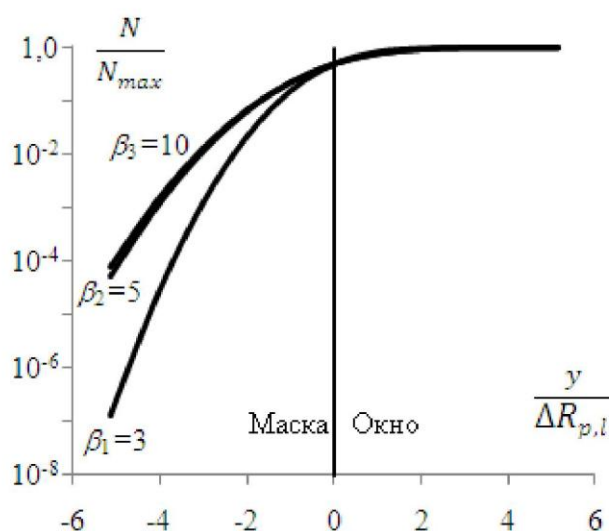


Рис. 2. Модельные профили поперечного распределения концентрации примеси при использовании маски

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. ..Комаров Ф.Ф. Ионная и фотонная обработка материалов. Мн.: Белгосуниверситет, 1998. 209 с.
2. H. Runge. Distribution of Implanted Ions under Arbitrarily Mask Edges/ Phys. Stat. Sol.(a), 1977 .vol.39, pp 595-599,
3. Буренков А.Ф., Комаров Ф.Ф., Темкин М.М. Аналитический расчет ионной имплантации через окно в маске // Микроэлектроника. 1987.- Т.16, №1. С.15–21.

УДК 531

**ТҮТҚЫР ҮЙКЕЛІС КҮШІ ЕСКЕРІЛГЕН ФИЗИКАЛЫҚ
 МАЯТНИКТИҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ**

Серикбаева Бибигүл Алиевна

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Механика кафедрасының магистранты,
 Ғылыми жетекші – М.Ә.Берсүгір
 Нұр-Сұлтан, Қазақстан